

## 36-30 半導体電気計測用ナノプロービングシステムの開発

大学院自然科学研究科	教 授	久保田 弘
電気システム工学科	助 授	中 田 明 良
大学院自然科学研究科	前期課程	居 村 史 人
		板 倉 敬 二 郎
	後期課程	小 坂 光 二
		江 頭 義 也
		万 化

LSIの設計・加工寸法は、100nm以下の領域に達し、従来のプローバでは実回路上に直接プローブを当てて電気特性を測定することは困難である。我々は、走査型電子顕微鏡(SEM)下で加工寸法がナノメートル領域の半導体デバイスを観察しながら、先端径0.5nm以下の微小電極プローブを位置決め分解能10nmを有するナノマニピュレータで移動させ、実回路上の半導体デバイスの電気的特性を測定するシステムを開発した。

(第2回 東北大学・熊本大学 大学間連携技術交流会 2002.3.21)